

NPN POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN

Complementary of BDX 14, BDX 18
 Complémentaires des BDX 14, BDX 18

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
 Structure : Homobase

Matériau : Silicium
 Structure : Homobase :

- General purpose
 Usage général
- LF Amplifier
 Amplification basse fréquence

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ and configuration
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boîtier d'origine) $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ and configuration

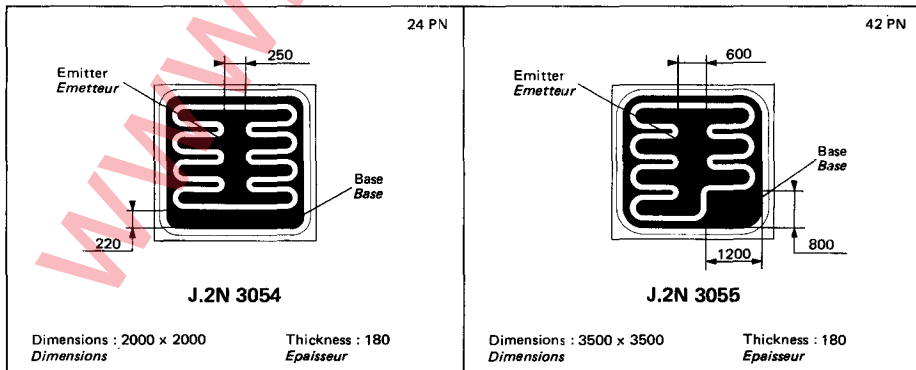
Type	P_{tot} (W)	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	V_{CEX} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (A)	t_{stg} ($^{\circ}\text{C}$)		t_j ($^{\circ}\text{C}$)
							min.	max.	max.
J.2N 3054	29 (1)	90	55	90	7	4 (1)	-65	+200	+200
J.2N 3055	117 (2)	100	60	100	7	15(2)	-65	+200	+200

- (1) When mounted in TO-66 case, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$
 Quand la pastille est montée en boîtier TO-66, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$
- (2) When mounted in TO-3 case, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$
 Quand la pastille est montée en boîtier TO-3, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium (Base-emitter)
 Back metallization : Gold (Collector) See page 60
 All dimensions in μm

Métallisation face avant : Aluminium (Base - émetteur)
 Métallisation face arrière : Or (Collecteur) Voir page 60
 Dimensions en μm



STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes)

$t_{amb} = 25^{\circ}C$

Type	$V_{(BR)CEO} / I_C$		$V_{(BR)CER} / I_C / R_{BE}$			$V_{(BR)EBO} / I_E$		I_{CEX} / V_{CE}		$h_{21E} / I_C / V_{CE}$			
	(V)	(mA)	(V)	(mA)	(Ω)	(V)	(mA)	(mA)	(V)	min.	max.	(A)	(V)
J.2N 3054	55	100	60	100	100	7	1	1	90	25	100	0,5	4
J.2N 3055	60	200	70	200	100	7	5	5	100	20	70	4	4

*Pulsed
En impulsions

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine)

$t_{amb} = 25^{\circ}C$

Type	$f_T / I_C / V_{CE}$		
	(MHz)	(A)	(V)
J.2N 3054	0,8	0,2	10
J.2N 3055	0,8	1	10

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine)

$t_{amb} = 25^{\circ}C$

Type	$V_{BE} / I_C / V_{CE}$			$V_{CEsat} / I_C / I_B$			$I_{CEX} / V_{CE} / t_j$		
	(V)	(A)	(V)	(V)	(A)	(A)	(mA)	(V)	($^{\circ}C$)
J.2N 3054	1,7	0,5	4	1	0,5	0,05	5	30	150
J.2N 3055	1,8	4	4	1,1	4	0,4	10	60	150

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71